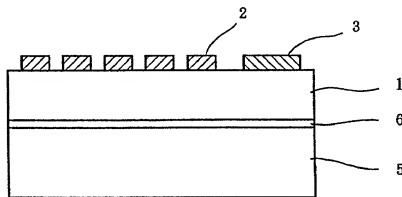




<p>(51) 国際特許分類 H01L 31/10, 31/08</p>	<p>A1</p>	<p>(11) 国際公開番号 WO00/17941</p> <p>(43) 国際公開日 2000年3月30日 (30.03.00)</p>
<p>(21) 国際出願番号 PCT/JP99/04993</p> <p>(22) 国際出願日 1999年9月13日 (13.09.99)</p> <p>(30) 優先権データ 特願平10/265506 1998年9月18日 (18.09.98) JP 特願平10/265516 1998年9月18日 (18.09.98) JP</p> <p>(71) 出願人 (米国を除くすべての指定国について) 三菱電線工業株式会社 (MITSUBISHI CABLE INDUSTRIES, LTD.) [JP/JP] 〒660-0856 兵庫県尼崎市東向島西之町8番地 Hyogo, (JP) 株式会社 ニコン (NIKON CORPORATION) [JP/JP] 〒100-8331 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号 Tokyo, (JP)</p> <p>(72) 発明者; および (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ) 只友一行 (TADATOMO, Kazuyuki) [JP/JP] 岡川広明 (OKAGAWA, Hiroaki) [JP/JP] 大内洋一郎 (OUCHI, Yoichiro) [JP/JP] 潮東雅弘 (KOTO, Masahiro) [JP/JP] 〒664-0027 兵庫県伊丹市池尻4丁目3番地 三菱電線工業株式会社 伊丹製作所内 Hyogo, (JP)</p> <p>(81) 指定国 CA, KR, US, 欧州特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE)</p> <p>添付公開書類 国際調査報告書</p>		

(54) Title: SEMICONDUCTOR PHOTODETECTOR

(54) 発明の名称 半導体受光素子



(57) Abstract

A semiconductor photodetector comprising a photodetecting layer (1) made of a GaN semiconductor and an electrode (2) so provided light (L) can be incident on a light-detecting surface (1a) which is one side of the photodetecting layer (1). If the photodetector is of Schottky barrier type, the electrode (2) includes a Schottky electrode so provided that the total length of the boundary line between the portion covered with the Schottky electrode of the photodetecting surface (1a) and the portion exposed is longer than the outer periphery of the photodetecting surface (1a). If the photodetector is of photoconductive type, the photodetecting layer (1) is an i layer of first conductivity type, the electrode (2) is an ohmic electrode of one polarity, and an ohmic electrode of the other polarity is provided on the other side of the photodetecting layer (1) directly or through a low-resistance GaN semiconductor layer of first conductivity type.